Family list 3 family members for: JP9186312 Derived from 2 applications.

> 1 DEVICE FOR DISPLAY AND IMAGE PICKUP Publication info: JP3436629B2 B2 - 2003-08-11

info: JP3436629B2 B2 - 2003-08-11 JP9186312 A - 1997-07-15

2 Display device having display and imaging pixels sandwiched between same substrates

Publication info: **US6040810** A - 2000-03-21

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat (c) 2004 EPO. All rts. reserv.

13826633

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 9186312 A2 19970715 <No. of Patents: 003>

DEVICE FOR DISPLAY AND IMAGE PICKUP (English)

Patent Assignee: SHARP KK

Author (Inventor): NISHIMURA TOSHIO

IPC: *H01L-029/762; H01L-021/339; G02F-001/13; G09F-009/00; H01L-027/148;

H04N-005/335; H04N-005/66; H04N-007/14

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 9186312 A2 19970715 JP 96775 A 19960108 (BASIC)

JP 3436629 B2 20030811 JP 96775 A 19960108 US 6040810 A 20000321 US 779529 A 19970107

Priority Data (No,Kind,Date): JP 96775 A 19960108

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05571512 **Image available**
DEVICE FOR DISPLAY AND IMAGE PICKUP

PUB. NO.: **09-186312** [JP 9186312 A] PUBLISHED: July 15, 1997 (19970715) INVENTOR(s): NISHIMURA TOSHIO

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 08-000775 [JP 96775]

FILED: January 08, 1996 (19960108)

INTL CLASS: [6] H01L-029/762; H01L-021/339; G02F-001/13; G09F-009/00;

H01L-027/148; H04N-005/335; H04N-005/66; H04N-007/14

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 29.2 (PRECISION

INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 44.6 (COMMUNICATION --

Television); 44.9 (COMMUNICATION -- Other)

JAPIO KEYWORD:R004 (PLASMA); R011 (LIQUID CRYSTALS); R097 (ELECTRONIC

MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors, MOS); R098

(ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements, CCD & BBD)

; R131 (INFORMATION PROCESSING -- Microcomputers &

Microprocessers)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to make easily an adjustment of a light-receiving quantity at the time of an image pickup by a method wherein electrodes and an electrode are respectively formed on the opposed surfaces of one pair of substrates, a multitude of light-receiving elements are arranged on each of the surfaces of the substrates and a means for leading out individually the output of each light-receiving element is provided.

SOLUTION: Pixel electrodes 14 for attaining a display function and a common electrode 15 common to these pixel electrodes 14 are respectively formed on the opposed surfaces of one pair of substrates 12 and 13, which are arranged at an interval and consist of a light-transmitting electrically insulative material, such as a transparent glass. A liquid crystal 16, which is a dielectric material, is interposed between the substrates 12 and 13. Polarizing plates 17 and 18 are respectively formed on the outer surfaces of the substrates 12 and 13. A condensing lens 19 is provided in the front, which is positioned on the side of an operator, of a device, the real image of the face of the operator or the like be imaged by this lens 19 is formed extending over the surface, which faces the liquid crystal 16, of the substrate 12 and an image, which is displayed by the liquid crystal 16, is enlarged, for example, and can be seen in the front.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-186312

(43)公開日 平成9年(1997)7月15日

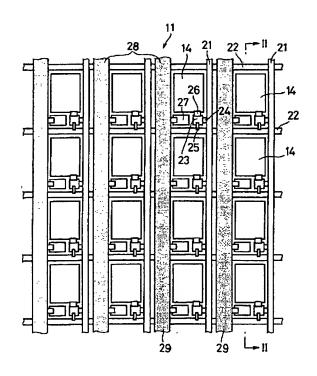
(51) Int. Cl. 6	識別記号		FΙ				_	
H01L 29/762				29/76		301	F	
21/339			G02F	1/13		505		
G02F 1/13	505		G09F	9/00		366	E	
G09F 9/00	366		H04N	5/33	5		A	
H01L 27/148				5/66		102	A	
		審查請求	未請求	請求」	項の数11	OL	(全18頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平8-775		(71)出	願人	00000504	19		
					シャープ	株式会	社	
(22)出顧日	平成8年(1996)1月8日		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号					
			(72)発明者 西村 敏夫					
					大阪府大	阪市阿	倍野区長池町	町22番22号 シ
					ャープ株	式会社	内	
			(74) (4	理人	弁理士			
			,		<i>,,</i>			

(54) 【発明の名称】表示および撮像のための装置

(57)【要約】

【課題】 テレビジョン電話装置において、相手の顔の画像を見ている目線に沿って対話中の自然に形で、操作者の自己の顔を撮像することができる装置を提供すること。

【解決手段】 透過形アクティブマトリクス液晶表示装置の液晶が介在された一対の基板の対向する表面に、各画素電極に隣接して多数のホトダイオードを配置し、各ホトダイオードの出力をCCD(電荷結合素子)の走査機能を用いるいわゆるインタライン転送方式で読出す。



٠.

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の各基板の対向する各表面に電極を それぞれ形成して画素を構成し、各基板間に誘電体を介 在して表示機能を達成するとともに、

1

前記表面に、多数の受光素子を配置し、

各受光素子の出力を個別的に導出する手段を備えて撮像 機能を達成することを特徴とする表示および撮像のため の装置。

【請求項2】 前記出力手段は、

半導体から成り、

各列毎の受光素子の出力を並列に読出し、かつ直列ビットで列方向にシフトする列シフトレジスタと、

各列シフトレジスタの出力を、共通の出力端子に直列ビットで、各列シフトレジスタ毎に順次的に導出する行シフトレジスタとを含むことを特徴とする請求項1記載の表示および撮像のための装置。

【請求項3】 列シフトレジスタと行シフトレジスタとは、電荷結合素子を用いて走査する構成を有することを 特徴とする請求項2記載の表示および撮像のための装 置。

【請求項4】 一方の基板の他方の基板に対向する前記 表面上に、

行列状に配置された画素電極と、

列方向に延びる複数のゲートラインと、

行方向に延びる複数のソースラインとが形成され、

ゲートラインとソースラインとの交差点に対応して薄膜トランジスタが設けられ、この薄膜トランジスタは、ソースラインに接続されるソース電極と、ゲートラインに接続されるゲート電極と、画素電極に接続されるドレン電極とを有し、ゲートラインに与えられる一方レベル電 30 圧でソース電極とドレン電極とが導通し、他方レベルで遮断し、

前記他方の基板の前記一方の基板に対向する前記表面上 に、画素電極に対向する共通電極が形成され、

ソースラインと共通電極との間に、誘電体を活性化するしきい値以上の表示用電圧を与え、ゲートラインに薄膜トランジスタが導通または遮断する制御電圧を与える手段を含むことを特徴とする請求項1~3のうちの1つに記載の表示および撮像のための装置。

【請求項5】 画素電極の列方向に隣接するソースライ 40 ンとの間に、薄膜トランジスタと受光素子とが画素電極の行方向に隣接して配置されることを特徴とする請求項 4記載の表示および撮像のための装置。

【請求項6】 受光素子の受光面上に、透光性を有する 受光量調整用個別電極が形成され、

受光素子が形成されている基板に対向するもう1つの基板に形成されている電極との間の電圧に依存する誘電体の光の透過率を変化して、その誘電体を介する受光面への受光量を調整することを特徴とする請求項1~5のうちの1つに記載の表示および撮像のための装置。

【請求項7】 前記一方の基板の前記表面上に、ソースラインに沿って隣接して受光量調整用ラインと、受光素子とが形成され、

この受光量調整用ラインに、受光量調整用個別電極が接続されることを特徴とする請求項6記載の表示および撮像のための装置。

【請求項8】 受光量調整用個別電極は、

画素電極に比べて、共通電極との間隔が小さく選ばれる とともに、ソースラインに接続され、

10 ソースラインには、時間が交互に設定される表示期間と 受光量調整期間とにおいて、電圧が印加され、この受光 量調整期間の電圧は、表示期間の表示用電圧よりも低く かつ画素電極と共通電極との間に存在する誘電体が活性 化されない値に選ばれることを特徴とする請求項6記載 の表示および撮像のための装置。

【請求項9】 受光素子の受光面上に、透光性を有する 受光量調整用個別電極が形成され、

受光量調整用個別電極は、ソースラインに接続され、

ソースラインには、時間が交互に設定される表示期間と 20 受光量調整期間とにおいて、電圧が印加され、

この受光量調整期間には、ゲートラインに薄膜トランジスタが遮断したままになる電圧が与えられることを特徴とする請求項4記載の表示および撮像のための装置。

【請求項10】 一対の各基板は、透光性を有し、 受光素子の背後に、遮光層が形成されることを特徴とす る請求項1~8のうちの1つに記載の表示および撮像の

【請求項11】 (a)操作者に臨んで配置される表示 /撮像装置であって、一対の各基板の対向する各表面に 電極をそれぞれ形成して画素を構成し、各基板間に誘電 体を介在して表示機能を達成するとともに、

前記表面に、多数の受光素子を配置し、

各受光素子の出力を個別的に導出する手段を備える表示 /撮像装置と、

- (b) 通信回線を介する映像信号を受信して画素電極に 与えて表示動作を行わせる映像駆動手段と、
- (c) スピーカと、

ための装置。

- (d)通信回線を介する音声信号を受信してスピーカを 駆動する音声駆動回路と、
- (e) マイクロホンと、
- (f) 前記出力手段とマイクロホンとからの出力を通信回線に送信する送信手段とを含むことを特徴とするテレビジョン通信装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、表示機能と撮像機能とを達成する装置に関する。

[0002]

【従来の技術】典型的な先行技術は、図27に示されて 50 いる。このテレビジョン電話装置1は、パーソナルコン . .

ピュータ2とテレビカメラ3とを備える。パーソナルコ ンピュータ2は、中央処理装置を含むパーソナルコンピ ュータ本体4と、テンキーを含む操作されるキーボード 5と、陰極線管などの表示装置6とを備える。表示装置 6には、テレビジョン電話の相手の顔などの画像が電話 回線を介して受信されて表示される。操作者である自己 の顔は、表示装置6の上方に設けられたテレビカメラ3 によって撮像されてその信号が電話回線を介して送信さ れる。さらにパーソナルコンピュータ2に関連して、テ レビの音声を出力するスピーカ7と自己の音声を送信す 10 るためのマイクロホン8とが備えられる。

【0003】図27に示される先行技術では、操作者は 表示装置6の画面を見ており、したがってテレビカメラ 3は、操作者が常にうつむいた顔を撮像することにな る。そのため操作者の正面から見た顔の表情をテレビカ メラ3によって撮像することができず、テレビジョン電 話装置の機能が劣ることになる。

【0004】他の先行技術は、特開平5-14880に 開示されている。この先行技術では、画像表示装置の側 部に電荷結合素子(略称CCD)を用いた2次元イメー 20 ジセンサから成る固体撮像素子が設けられる。この固体 撮像素子によって表示画面を見ている操作者の顔のやや 側部を撮像することになり、顔の正面を撮像することは できない。

【0005】さらに他の先行技術は、特開平6-245 209に開示される。このカメラ一体形ディスプレイ装 置では、液晶表示部の背後に設けてある偏光板に孔を設 け、この孔から取込んだ光をテレビカメラに入光して撮 像する。

【0006】この先行技術によれば、液晶表示部を見て 30 いる操作者の顔を正面からテレビカメラによって撮像す ることができるという利点がある。しかしながら上述の ように偏光板にテレビカメラへの入光のための孔が形成 されているので、表示画面に欠陥が生じてしまうという 点がある。

【0007】他の先行技術は、特開平1-106467 および特開平5-276313に開示されている。これ らの先行技術は、パーソナルコンピュータおよびワード プロセッサなどに接続され、原稿に密着して原稿を読取 話装置などの用途において、撮像位置から離間した操作 者の画像などの対象物を撮像することはできず、用途が 限定される。

【0008】従来からの撮像装置では、撮像素子に入力 される受光量、したがって露出の調整は、口径を変化す る機械的構造を有する絞り機構を用いる。この構成によ れば、大形化することは明らかであり、製品のコストダ ウンを妨げる主な原因になる。

【0009】従来からのいわゆる電子アイリス機能を有 するCCDなどのイメージセンサでは、受光感度の制御 50 ている基板に対向するもう1つの基板に形成されている

を電子シャッターによって達成するものであり、本格的 な露光調節機能とは異なる。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、表示 機能を達成する構成と、撮像機能を達成する構成とを一 体化し、表示品質を低下させることなく撮像を行うこと ができるようにし、しかも構成を小形化、簡略化するこ とができるようにした表示および撮像のための装置を提 供することである。

【0011】本発明の他の目的は、撮像時における受光 量の調整を容易に行うことができるようにした表示およ び撮像のための装置を提供することである。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、一対の各基板 の対向する各表面に電極をそれぞれ形成して画素を構成 し、各基板間に誘電体を介在して表示機能を達成すると ともに、前記表面に、多数の受光素子を配置し、各受光 素子の出力を個別的に導出する手段を備えて撮像機能を 達成することを特徴とする表示および撮像のための装置 である.

また本発明は、前記出力手段は、半導体から成り、各列 毎の受光素子の出力を並列に読出し、かつ直列ピットで 列方向にシフトする列シフトレジスタと、各列シフトレ ジスタの出力を、共通の出力端子に直列ビットで、各列 シフトレジスタ毎に順次的に導出する行シフトレジスタ とを含むことを特徴とする.

また本発明は、列シフトレジスタと行シフトレジスタと は、電荷結合素子を用いて走査する構成を有することを 特徴とする。

また本発明は、一方の基板の他方の基板に対向する前記 表面上に、行列状に配置された画素電極と、列方向に延 びる複数のゲートラインと、行方向に延びる複数のソー スラインとが形成され、ゲートラインとソースラインと の交差点に対応して薄膜トランジスタが設けられ、この 薄膜トランジスタは、ソースラインに接続されるソース 電極と、ゲートラインに接続されるゲート電極と、画素 電極に接続されるドレン電極とを有し、ゲートラインに 与えられる一方レベル電圧でソース電極とドレン電極と が導通し、他方レベルで遮断し、前記他方の基板の前記 って表示する機能を有する。したがってテレビジョン電 40 一方の基板に対向する前記表面上に、画素電極に対向す る共通電極が形成され、ソースラインと共通電極との間 に、誘電体を活性化するしきい値以上の表示用電圧を与 え、ゲートラインに薄膜トランジスタが導通または遮断 する制御電圧を与える手段を含むことを特徴とする また本発明は、画素電極の列方向に隣接するソースライ

ンとの間に、薄膜トランジスタと受光素子とが画素電極 の行方向に隣接して配置されることを特徴とする また本発明は、受光素子の受光面上に、透光性を有する

受光量調整用個別電極が形成され、受光素子が形成され

. .

電極との間の電圧に依存する誘電体の光の透過率を変化 して、その誘電体を介する受光面への受光量を調整する ことを特徴とする.

5

また本発明は、前記一方の基板の前記表面上に、ソース ラインに沿って隣接して受光量調整用ラインと、受光素 子とが形成され、この受光量調整用ラインに、受光量調 整用個別電極が接続されることを特徴とする。

また本発明は、受光量調整用個別電極は、画素電極に比べて、共通電極との間隔が小さく選ばれるとともに、ソースラインに接続され、ソースラインには、時間が交互 10 に設定される表示期間と受光量調整期間とにおいて、電圧が印加され、この受光量調整期間の電圧は、表示期間の表示用電圧よりも低くかつ画素電極と共通電極との間に存在する誘電体が活性化されない値に選ばれることを特徴とする。

また本発明は、受光素子の受光面上に、透光性を有する 受光量調整用個別電極が形成され、受光量調整用個別電 極は、ソースラインに接続され、ソースラインには、時 間が交互に設定される表示期間と受光量調整期間とにお いて、電圧が印加され、この受光量調整期間には、ゲー 20 トラインに薄膜トランジスタが遮断したままになる電圧 が与えられることを特徴とする。

また本発明は、一対の各基板は、透光性を有し、受光素子の背後に、遮光層が形成されることを特徴とする。また本発明は、(a)操作者に臨んで配置される表示/撮像装置であって、一対の各基板の対向する各表面に電極をそれぞれ形成して画素を構成し、各基板間に誘電体を介在して表示機能を達成するとともに、前記表面に、多数の受光素子を配置し、各受光素子の出力を個別的に導出する手段を備える表示/撮像装置と、(b)通信回 30線を介する映像信号を受信して画素電極に与えて表示動作を行わせる映像駆動手段と、(c)スピーカと、

- (d) 通信回線を介する音声信号を受信してスピーカを 駆動する音声駆動回路と、(e) マイクロホンと、
- (f) 前記出力手段とマイクロホンとからの出力を通信 回線に送信する送信手段とを含むことを特徴とするテレ ビジョン通信装置である。

【0013】本発明の表示および撮像のための装置は、たとえばテレビジョン電話装置、テレビジョン会議システムおよび建物の玄関と建物内部とで相互に相手の顔の 40画像を見ながら通話を行うことができるドアホンなどのテレビジョン通信装置などを含むテレビジョン通信装置の用途に好適に実施することができる。

本発明に従えば、表示機能を達成するために一対の各基板の対向する各表面に電極を形成して画素を構成し、誘電体、たとえば好ましくは液晶、エレクロトルミネセンス材料およびプラズマ表示を達成する材料などを介在して構成し、この表面には多数の受光素子、たとえばホトダイオードを、行列状に規則正しく配置し、または分散してランダムに配置し、これらの受光素子の出力を個別50

的に出力手段によって導出する。したがってたとえばテレビジョン通信装置の用途では、通話中の相手の顔の画像が表示された状態で、その相手の顔の画像を見ながら相手と同じ目線で自然に形で撮像が行われ、対話することができるようになる。

本発明に従えば、前記出力手段は、半導体によって構成 される列および行の各シフトレジスタを用い、たとえば CCD (電荷結合素子)による走査機能によって、受光 素子の出力を転送して出力し、構成の小形化を図ること ができるとともに、受光素子による表示品質の低下を招 来することがない。

本発明に従えば、表示機能を達成するために液晶などの誘電体を用い、いわゆるダイナミック表示を行うアクティブマトリクス表示を達成する構成を有する。画素電極に表示駆動のための電圧を与えるために、たとえば金属酸化物電界効果トランジスタ(略称MOS FET)などから成る薄膜トランジスタ(略称TFT)を用いることができ、あるいはまた予め定めるしきい値以上の電圧を印加することによって導通するMIM(Metal-Insulator-Metal)素子などのスイッチング素子、およびその他のスイッチング素子が用いられてもよい。これらの薄膜トランジスタなどのスイッチング素子と、受光素子とは、画素電極に隣接してそれぞれ設けられることができる。

さらに本発明に従えば、受光素子の受光面上に、透光性の受光量調整用個別電極を形成して誘電体の光の透過率を変化し、受光面への受光量の調整を行うことができ、本格的な露出調節機能を提供することができる。この構成は、在来の前述した電子アイリス機能を備えるCCDなどのイメージセンサとは原理が全く異なり、本発明によって簡略な電気的構成で機械式と同等の本格的な露出調整機能を実現することができる。

受光量調整用個別電極に受光量調整のための電圧を印加するにあたり、受光量調整用ラインを基板の前記表面に形成してもよいが、他の実施の形態では、基板の構成をさらに簡単化するために、受光量調整用個別電極とそれに対向する共通電極との間の間隔を、画素電極と共通電極との間の間隔未満に選び、これによって表示期間では表示のための画素電極と共通電極との間に比較的高い表示用電圧を印加して表示機能を達成し、受光量調整期間では誘電体が活性化されるしきい値未満の比較的低い電圧を受光量調整用個別電極と共通電極との間に印加して表示機能を達成し、こうして基板の表面に形成された薄膜トランジスタのためのソースラインを、表示と受光量調整のために共用化し、構成の簡略化を図ることができ

さらに本発明に従えば、背後にバックライトと称される 光源を配置していわゆる透過形表示のための構造とし、 この構成において、光源からの光によって受光素子が誤 動作することを防ぐために、受光素子の背後、すなわち 受光素子と光源との間に金属、たとえばアルミニウムま たは遮光性合成樹脂層などから成る遮光層を設ける 上述の本発明に従う表示および撮像のための装置をテレ ビジョン通信装置の用途において用いることによって、 相手と同じ目線で相手の顔の像を見ながら対話を自然な 形で行うことができるようになる。

7

本件表示および撮像のための装置では、一対の基板のう ち、操作者側の前方に配置された一方の基板よりも前方 には、表示/受光面の多数の受光素子にわたって操作者 のたとえば顔などの画像を結像する集光レンズが配置さ 10 れる。これによって受光素子は、結像された画像の各部 分の光強度に対応するレベルを有する電気信号を導出す る。この集光レンズによって、操作者は、表示された画 像を拡大して見ることができるという効果もまた、達成 される。

[0014]

【発明の実施の形態】図1は本発明の実施の一形態の表 示および撮像のための装置11の一部の平面図であり、 図2はその装置11の図1における切断面線 II-II から見た簡略化した断面図である。たとえばテレビジョ 20 ン電話装置などのテレビジョン通信装置において、ダイ ナミック駆動される透過形アクティブマトリクス形液晶 表示装置にホトダイオードである受光素子を備えた撮像 のための装置が一体的に複合されて、本発明に従う表示 および撮像のための装置が実現される。一対の間隔をあ けて配置された透光性、たとえば透明なガラスなどの電 気絶縁性材料から成る各基板12,13の対向する各表 面には、表示機能を達成するための画素電極14と、こ れらの画素電極14に共通の共通電極15とがそれぞれ 形成される。各基板12,13間には、誘電体である液 30 晶16が介在される。各基板12,13の外表面上に は、偏光板17,18が形成される。

【0015】操作者側である前方(図2の上方)には、 集光レンズ19が設けられ、これによって撮像されるべ き操作者などの顔の実像が、基板12の液晶16に臨む 表面にわたって結像されるとともに、液晶16によって 表示される画像がたとえば拡大されて前方で見ることが できる。基板12の背後(図2の下方)には、バックラ イトとしての機能を果たす面状光源20が配置される。

【0016】再び図1を参照して、画素電極14は、一 40 方の基板12の液晶16に臨む表面に行列状に配置され る。液晶電極14と共通電極15とは、透光性を有する 導電性材料、たとえばITO(インジウム錫酸化物)な どから成る。複数のゲートライン21は、列方向に延 び、また複数のソースライン22は行方向に延びて、基 板12の表面に形成される。

【0017】金属酸化膜電界効果トランジスタ(略称M OS FET) から成る半導体スイッチング素子である 薄膜トランジスタ23は、ソースライン22に接続され るソース電極25と、ゲートライン21に接続されるゲ 50 る。蓄積期間が終わると、これらの信号電荷を、全画素

ート電極24と、画素電極14に接続されるドレン電極 26とを有する。この薄膜トランジスタ23は、ゲート ライン21からゲート電極24に選択的に与えられる一 方レベルの制御電圧によって、ソース電極25とドレン 電板26とが導通してソースライン22の表示用電圧が 個別電極14に印加される。ゲートライン21に他方レ ベルの電圧が与えられることによって薄膜トランジスタ 23は遮断し、ソースライン22の電圧は画素電極14 に与えられない。こうして各ソースライン22に順次的 に表示用電圧が与えられている期間において、表示すべ き画像に対応してゲートライン21に前記一方レベルの 制御電圧が順次的に選択して印加されて走査されること によって、希望する画素電極14と共通電極15との間 に介在されている液晶16が活性化されて画素毎の表示 が行われる。ソースライン22に与えられる表示用電圧 は、液晶を活性化するしきい値以上の電圧に選ばれる。

【0018】画素電極14の列方向(図2の上下方向) に隣接するソースライン22との間に、薄膜トランジス タ23と、撮像のためのホトダイオードである受光素子 27とが配置される。受光素子27は、画素電極14と 同様に、規則正しく行列状に配置される。

【0019】受光素子27の出力を個別的に導出するた めに、次に述べる出力手段28が設けられる。

【0020】図3は一方の基板12の液晶16側から見 た簡略化した平面図であり、前述の図1はこの図3に示 される構成の一部を拡大した平面図である。出力手段2 8は、半導体から成る。この出力手段28は、各列毎の 受光素子27の出力を並列に読出し、かつ直列ビットで 列方向に図1および図2の上方から下方に転送してシフ トする列シフトレジスタ29と、各列シフトレジスタ2 9の出力を、直列ビットで各列シフトレジスタ29毎に **順次的に導出する単一の行シフトレジスタ30とを含** む。行シフトレジスタ30は、出力端子31に、各列シ フトレジスタからの出力、したがって全ての各受光素子 27の出力を導出する。こうしていわゆるインタライン 転送方式が実現される。

【0021】図4は、出力手段28の構成を簡略化して 示す平面図である。各列シフトレジスタ29は、その各 列シフトレジスタ23に対応する列方向に配置された受 光素子27の出力を矢符32で示されるように各列毎に 一斉に読出し、各列シフトレジスタ毎に、行シフトレジ スタ30に矢符33で示されるように転送して導出す る。行シフトレジスタ30と出力端子31との間に、半 導体素子によって実現される増幅回路34が介在され

【0022】図5は、図4に示される撮像のための受光 素子27からの信号を出力する構成をさらに具体的に示 す電気回路図である。受光素子27で発生した信号の電 荷は、電荷蓄積動作によって、各接合容量に蓄積され

同時に隣の垂直転送用の列シフトレジスタ29に送る。 信号電荷は、その後、列シフトレジスタ29に加えられ る列クロックパルス φ v 1 ~ φ v 4 に同期して図 4 およ び図5の下方に転送される。出力端子31への読出し は、列シフトレジスタ29の一列分ずつの電荷を、埋込 みチャネルを用いた水平転送のための行シフトレジスタ 30に送り、順次出力する。行シフトレジスタ30によ る信号電荷の転送のために、行クロックパルス Φ h 1 ~ φh4が用いられる。1フィールド分の信号電荷が読出 されると、再び受光素子27に蓄積された次のフィール 10 ドの信号電荷を、上述と同様に順次出力端子31に転送 して読出す。このようにして全画面が繰返して走査され

【0023】図6は受光素子27と列シフトレジスタ2 9との具体的な構成を示す平面図であり、理解の便宜の ために部分的に斜線を施して示す。図7は、図6の切断 面線A-B-C-Dから見た断面図である。列シフトレ ジスタ29および行シフトレジスタ30はいずれも、2 層ポリSi重合せゲート電極構造による埋込みチャネル CCDであって、4層駆動方式で転送を行う。増幅回路 20 34は、浮遊拡散層による電荷検出ダイオードと2段ソ ースホロワによって構成される。奇数番目の受光素子2 7 (2 i + 1) と偶数番目の受光素子27 (2 i) の合 計2個が列シフトレジスタ1ピットに対応する。 i は自 然数である。

【0024】一方の基板12上において、列シフトレジ スタ29が形成されるべき位置には、Siなどの半導体 から成るn層37が形成され、その上にpウエル層38 が形成される。受光素子27は、pウエル層38に形成 された n^- 領域39と、その上に形成された n^+ 層40が形成されて、n'n'pn構造によって構成される。n 領域39は、強い光の入射時に発生する過剰電荷のn 層37への排出経路となるとともに、中波長管路の構造 と分光管路の変動の軽減に寄与する。このような n^t n⁻ pn構造では、ブルーミング抑圧時においてもn 層3 9の下端まで実効光電変換領域が確保されることにな る。

【0025】また電荷転送のための埋込みチャネルCC Dを構成するために、pウエル層38にn 領域41が ための電極42と、構造する電極43,44,45が部 分的に重なって順次的に形成される。さらに遮光のため のたとえばアルミニウムなどの材料から成る遮光層46 が形成される。

【0026】これらの半導体層上には、図7の参照符4 8に示されるように、透光性電気絶縁層が形成され、た とえばSiOzなどから成る。各列毎の受光素子27に 近接してチャネルストップ層49が形成され、相互の干 渉が防がれる。また上下のポリSi層50,51が形成 配線にフィールドプレートの機能を持たせ、列シフトレ ジスタ29に沿って線状に形成され、画素を水平方向 に、すなわち図6の左右方向に分離する。出力端子31 から導出される画像の各画素毎の出力信号は、たとえば NTSCおよびPALなどのテレビジョン映像信号とし て生成され、水平方向1ラインおきにインタレース走査 され、奇数フィールドと偶数フィールドとの合計2つの フィールドによって1フレームが構成される。

【0027】図8は、図7に示される受光素子27に関 連する各部分のチャネル電位を時間経過に伴って示して おり、これらの図8(2)~図8(4)にそれぞれ示さ れる時刻 t=t1, t2, t3は、図9の各時刻に対応 する。図9(1)~図9(4)は、列シフトレジスタ2 9に与えられる列クロックパルスφν1~φν4であ り、これらの各列クロックパルスは、電圧VH、VI, VL(ただしVH>VI>VL)の各値に時間経過に伴 って定められる。pウエル層38は、n層37との間に 印加された逆バイアス電圧による空乏化し、これによっ てブルーミングだけでなく、スミアも抑圧される。受光 素子27の下部のpウエル層38だけでなく、列シフト レジスタ29の下部のpウエル層38も浅いので、この 部分に完全に空乏化することによって、光電変換によっ て発生した電気の列シフトレジスタ29への流入が防止 され、スミアが抑制される。

【0028】受光素子27から列シフトレジスタ29へ の電子のドリフトによる導入のために、隣接するn[†] 領 域40からクロックφv1が与えられる電極42を介し てドリフト流入させ、こうして導入された電子に対して ポテンシャル移動が図1の上から下に向かって(すなわ 30 ち図6の上から下に向かって、図7および図8(1)の 右から左に向かって) 転送される。図8(2)~図8 (4)の斜線を施して示す部分は、ポテンシャル移動の 電子を示している。時刻 t 1 において、受光素子27 に

最も近接している電極42にクロックパルス φ v 1 が電 圧VHで与えられることによって、受光素子27から列 シフトレジスタ29に電荷が読出され、その後、時刻 t 2, t3, …の各時刻における列クロックパルスφν1 ~ φ v 4 によって電荷が順次的に転送される。多数の列 シフトレジスタ29のうちの1つから転送されてきた電 形成される。さらに受光素子27からの電荷を転送する 40 荷は、行シフトレジスタ30によって行クロックパルスを φh1~φh4に同期して増幅回路34に与えられて増 幅され、出力端子31から読出される。

【0029】図10は、受光素子27からの出力が出力 端子31から読出される全体の動作を簡略化して示す図 である。図10(1)は、前述の図8(2)および図9 における時刻 t 1の時刻に対応しており、各列の受光素 子27の出力を1つの列レジスタ29に一斉に読出して ラッチする動作を示す。図10(2)~図10(5) は、行方向に隣接する合計 n 個の列シフトレジスタ29 されている。このチャネルストップ層49は、クロック 50 毎に各列シフトレジスタ29にストアされている受光素 子27の出力を図4および図5の下方に順次的にシフトする動作を示している。行シフトレジスタ30は、図10(6)に示されるように、行クロックパルスゆh1~ゆh4に応答して直列ビットで順次的に、各列シフトレジスタ29からの出力を導出する。こうして出力端子31からは、図10(7)に示されるように受光素子27の受光量に対応したレベルを有する信号が得られる。

11

【0030】図11は本発明の実施の他の形態の一部の 平面図であり、図12は図11に示される形態の切断面 線 X I I - X I I から見た簡略化した断面図である。こ 10 の実施の形態は、前述の図1~図10に示される形態に 類似し、対応する部分には同一の参照符を付す。注目す べきはこの実施の形態では、受光素子27の受光面上 に、透光性を有する受光量調整用個別電極53が形成さ れ、この個別電極23は、たとえばITOなどの材料か ら成ってもよい。個別電極53は、導体54を介して受 光量調整用ライン55に接続される。この受光量調整用 ライン55は、基板12の個別電極14および受光素子 27が形成されている側の表面上で、ソースライン22 に沿って隣接して形成される。導体54は、絶縁層48 20 (前述の図7参照)を介してソースライン22と電気的 に絶縁される。こうして受光量調整用個別電極53は、 受光素子27の受光面に、透光性を有する電気絶縁膜を 介して形成される。

【0031】受光量調整用個別電極53には、受光量調 整用ライン55を介して全ての個別電極53に同一の受 光量調整用信号が印加され、このような受光量調整動作 は、液晶表示動作とは独立して制御回路によって制御さ れる。たとえば受光素子27と出力手段28とによって 構成される受光素子27の出力端子31から得られる出 30 力をモニタして検出し、その受光素子27から得られる 出力電圧が高すぎたり、受光素子27または増幅回路3 4が飽和しているときには、受光量調整用信号の電圧を 高く変化し、これによって受光素子27上に形成された 個別電極53と共通電極15との間に介在されている液 晶22を活性化して光の透過率を小さくし、すなわち濃 く印加させる。これによって受光素子27に入射する受 光量を少なくし、受光素子27の出力電圧を低下するこ とができる。これとは逆に受光素子27の出力電圧が低 すぎる場合には、受光量調整用ライン55に与える受光 40 量調整電圧を低く変化し、これによって受光素子27上 に存在する液晶22を不能動化して光の透過率を大きく し、濃度を薄く変化させ、これによって受光素子27に 入射する受光量を多くし、受光素子27の出力電圧を上 昇する。このような受光量調整用電圧は、連続的に変化 させ、受光素子27の出力電圧を連続的に調節すること ができる。

【0032】図13は、図11および図12に示される は表示用電圧V1が印加され、受光量調整期間W2で 本発明の実施の一態様の動作を説明するための簡略化し 安光量調整用電圧V2が印加される。この1つのソーた波形図である。図13(1)に示されるように、時刻 50 ライン22に図17に示される電圧が印加される状態

t 21~時刻 t 24においてハイレベルとなる受光量調 整用電圧を受光量調整用ライン55に与え、これによっ て受光量調整用個別電極53と共通電極15との間に介 在されている液晶16の光透過率を変化した状態とす る。この状態で、画素電極14から列シフトレジスタ2 9への読込みのために図13(2)に示されるパルスが 列シフトレジスタ29に与えられ、こうして得られた列 シフトレジスタ29の受光素子27の出力は、図13 (3) ~図13 (6) に示される列クロックパルスφ v 1~φν4を用いて直列ビットで順次的にシフトされて ゆく。その後、列シフトレジスタ29からの出力は行シ フトレジスタ30によって転送され、その行シフトレジ スタ30を含む出力手段28から増幅回路34には図1 3 (7) に示される信号が導出される。出力端子31に は、図13(8)に示される読出し信号に応答して、各 受光素子27の受光量に対応したレベルを有する信号が 読出される。図11~図13に示される本発明の実施の 一形態のその他の構成と動作は、前述の実施の形態と同 様である。

12

【0033】図14は本発明の実施の他の形態の図1および図11に対応する平面図であり、図15は図14の切断面線XV-XVから見た一部の断面図である。この実施の形態は、前述の実施の形態に類似し、対応する部分には同一の参照符を付す。注目すべきはこの実施の一形態では、ソースライン22に受光量調整用個別電極53が導体57を介して電気的に接続されており、前述の図11~図13に関連して述べた実施の一形態における受光量調整用ライン55が省略され、これによって本件装置の小形化を可能とし、画素電極14および受光素子27の実装密度を大きくすることができる。

【0034】図17は、図14~図16に示される本発明の実施の一形態の動作を説明するための簡略化した波形図である。複数nのゲートライン21には、図17(1)~図17(4)に示される波形を有する薄膜トランジスタ23が導通するための制御信号を与え、これらの制御信号は、たとえば図17(1)では時刻 t31~ t32の期間W1だけ継続し、また図17(2)に示されるように時刻 t33~ t34の期間W1だけ継続する。こうして期間W1は、画素電極14と共通電極15との間の液晶16が活性化されて表示が行われる表示期間である。液晶16に印加される電圧は、図17(6)に示される。

【0035】これらの表示期間W1の相互間である時刻 t32~t33において、受光量調整期間W2が設定される。こうして表示期間W1と受光量調整期間W2とが 交互に時間経過に伴って設定されることになる。ソース ライン22には、共通電極15に対して表示期間W1では表示用電圧V1が印加され、受光量調整期間W2では 受光量調整用電圧V2が印加される。この1つのソースライン22に図17に示される電圧が印加される状態

は、各ソースライン22毎に順次的に走査され、1つの ソースライン22に電圧が印加されている状態で、上述 のように複数のゲートライン21に制御電圧が順次的に 走査される。

【0036】受光量調整期間W2において、液晶16の 光透過率に対応する受光量調整用電圧V2がソースライ ン22および導体57を経て受光量調整用個別電極53 に印加され、この期間W2において、受光素子27の受 光量に対応する出力は、図17(6)に示される読出し クロック信号によって列シフトレジスタ29にシフトさ 10 れて読出され、その後、表示期間W1において列シフト レジスタ29を経てシフトされて転送される。その他の 動作は、前述の実施の一態様と同様である。

d1>d2

に選ばれる。

【0039】したがって図16に示されるように、受光 量調整用個別電極53と共通電極15との間に印加され る実効値電圧と液晶16のコントラストとの関係を表す 特性は、ラインL2で示され、また画素電極14と共通 V1>V2

この受光量調整用電圧V2の印加時において、画素電極 14と共通電極15との間の液晶16は活性化されない 値に選ばれている。

【0040】前述の式1による液晶16の活性化するた めのしきい値電圧の違いを利用して、図18に示される 動作が達成されてもよい。この図18(1)~図18 (7) の各波形は、前述の図17(1)~図17(7)

にそれぞれ対応している。注目すべきはこの発明の実施 の一形態では、各ゲートライン21には、図18(1) ~図18(4)に示されるように常時制御電圧が順次的 30 に印加されるように構成されており、画素電極14と共 通電極15との間には、図18(6)に示される電圧が 常時印加される。ソースライン22には、受光量調整期 間W2において、間隔d1を有する画素電極14と共通 電極15との間の液晶16が活性化されない前記電圧V 2が印加され、液晶表示が行われることはない。その他 の構成と動作は、前述の実施の各形態と同様である。

【0041】図14~図17の本発明の実施の一形態に おいて、d1=d2に選ばれてもよい。

【0042】図19は本発明の実施のさらに他の形態の 40 前述の図1に対応する一部の平面図であり、図20は図 19の切断面線 X X - X X から見た断面図である。この 実施の一形態の構成は、前述の図1~図10に関連して 説明した実施の一形態と類似するけれども、注目すべき はこの実施の一形態では、一方の基板12には、受光素 子27の背後に遮光層58が形成される。遮光層58 は、たとえばアルミニウムなどの金属蒸着膜などから成 ってもよく、または遮光性合成樹脂から成ってもよい。 これによって受光素子27には、光源20からの光が照 射されて誤動作することはない。

14

【0037】この図14~図17に示される本発明の実 施の一態様では、受光量調整期間W2では、ゲートライ ン21には制御電圧が印加されず、したがって薄膜トラ ンジスタ24は遮断している。この期間W2において、 受光素子27において希望する受光量が得られるように するための液晶16の光透過率が達成される電圧が選択

【0038】本発明の実施のさらに他の形態では、図1 5において、受光量調整用個別電極53は、画素電極1 4に比べて共通電極15との間隔が小さく選ばれ、すな わち受光量調整用個別電極53と共通電極15との間隔 をd2とし、画素電極14と共通電極15との間隔をd 1とするとき、

してソースライン22から印加される。

... (1)

電極15との間に印加される実行値電圧と液晶16のコ ントラストとの関係を示す特性はラインL1で示され る。受光量調整用電圧V2は、画素電極14の表示用電 圧V1よりも低く定められる。すなわち

... (2)

【0043】図21は、図19および図20に示される 本発明の実施の一形態における光源20からの光の進む 経路を示している。細かい点で示される領域59は、光 源20からの光が進んでいる領域を示し、白抜きの領域 60は、光源20からの光が照射されない部分を示して いる。この図21の図面からもまた、遮光層58によっ て受光素子27に光源20からの光が照射されないこと が理解される。これによって受光素子27の誤動作が防 がれる。

【0044】図22は、本発明の実施の他の形態の一部 の断面図である。この実施の一形態では、図19~図2 1の形態に類似するけれども、注目すべきは遮光層 6 1 は基板12の液晶16に臨む表面に形成され、この表面 に形成された遮光層61の上に、受光素子27が電気絶 縁層を介して形成される。

[0045] 図23は、本発明の実施のさらに他の形態 の断面図である。この実施の形態は、図19~図22の 各形態に類似し、注目すべきは受光素子27には、基板 12上の遮光層61だけでなく、さらに受光素子27の 両側部においても遮光層62、63が形成される。その 他の構成は、前述の実施の形態と同様である。遮光層 6 1~63は、金属蒸着層であってもよいけれども、導電 性のない顔料分散形の黒色有機材料などを用いてもよ い。遮光層58,61~63は、図11~図18の本発 明の各形態に関連して実施されてもよい。

【0046】図24は図1~図10に示される表示/撮 像装置11が搭載されたいわゆるノート形パーソナルコ ンピュータ形のテレビジョン電話装置64の簡略化した 斜視図である。この装置11は、本体65と蓋体66と 50 を有し、水平軸線を有するヒンジ67によって開閉可能 • .•

10

に設けられる。本体65には、操作者が操作するテンキ ーなどを含むキーボード68が搭載される。蓋体66に は、操作者に臨んで本発明に従う表示/撮像装置11が 装着される。さらに蓋体66には、スピーカ69と操作 者の音声を電気信号に変換するマイクロホン70とが設 けられる。操作者は、電話回線を介して受信されて装置 11に表示される相手の顔などの画像を見ながら通話す ることができる。操作者の顔などの画像は、装置11に よって撮像され、公衆電話回線75を介して相手に送信

15

【0047】図25は、図24に示されるテレビジョン 電話装置64の電気的構成を示すプロック図である。通 信回線である公衆電話回線75は、制御回路76におけ る結合回路77を介して、受信回路78に接続され、相 手の顔などの画像信号は受信回路78から駆動回路79 に与えられ、表示/撮像装置11においてその画像が表 示される。表示/画像装置11によって撮像された操作 者の顔などの画像信号は、読取り手段80を経て、送信 回路81から結合回路77に与えられ、公衆電話回線7 5に送信される。マイクロホン70による操作者の音声 20 の信号は増幅回路82によって増幅され、送信回路81 を経て、結合回路77から公衆電話回線75に送信され る。相手方の音声信号は、受信回路78から駆動回路8 3に与えられ、スピーカ69が駆動される。これらの各 構成要素77~83は、マイクロコンピュータなどによ って実現される処理回路84によって制御され、この処 理回路84には、キーボード68からのダイアル信号な どが与えられて、その動作の制御が行われる。

【0048】本発明は、薄膜トランジスタなどのスイッ 連して実施されるだけでなく、多数の行電極と多数の列 電極とが液晶などの誘電体を介して垂直に交差して構成 されるいわゆる単純マトリクス形表示装置に関連しても また、実施される。

【0049】図26は、本発明の実施のさらに他の形態 のテレビジョン電話装置71の簡略化した斜視図であ る。この実施の一形態でもまた本発明に従う表示/撮像 装置11が本体72に装着され、スピーカ69とマイク ロホン70が設けられる。表示装置11はまたテンキー を含む入力手段を兼用しており、入力点73の接触また 40 は押圧操作によってまたは操作者の手の指などの操作に よって、ダイヤル番号などの入力操作を行うことができ る。

[0050]

【発明の効果】本発明によれば、一対の各基板の対向す る各表面に画素を構成するための電極をそれぞれ形成 し、これらの基板間に誘電体を介在して表示を行うよう にし、しかもこれらの対向する表面に、多数の受光素子 を配置して各受光素子の出力を出力手段によって個別的 に導出して撮像機能を達成することができる。したがっ 50 一層簡略化して受光量の調整を行うことができるように

て表示機能を達成する表示領域と同一領域内で撮像を行 うことができるようになり、これによってたとえばテレ ビジョン通信装置などにおいて、たとえば相手の顔が表 示された画像を見ながら操作者である自己の顔が撮像さ れることになり、したがって相手と同じ目線で自然な状 態で対話することなどが達成され、こうして先行技術に 比べて一層自然なユーザ・インタフェイスおよびマン・ マシン・インタフェイスを実現することができる。

【0051】本発明によれば、受光素子の出力を導出す る出力手段は、たとえばCCDなどの電荷転送デバイス によって実現し、構成の小形化を図ることができる。特 に受光素子の出力を並列に読出して直列ビットでシフト する列シフトレジスタと、各シフトレジスタの出力を共 通の出力端子に直列ピットでシフトして導出する行シフ トレジスタとを用いて、たとえばインタライン伝送方式 で各受光素子の出力を転送することによって、構成の簡 略化を図ることができる。

【0052】さらに本発明によれば、表示機能を達成す るために、たとえば薄膜トランジスタなどの半導体スイ ッチング素子を用いてダイナミック駆動によるアクティ ブマトリクス表示を達成し、その薄膜トランジスタなど の半導体スイッチング素子と受光素子とを各画素電極に 隣接して配置し、表示品質の向上を図るとともに、その 画素電極の数とほぼ同一数の受光素子を用いて撮像品質 の向上もまた図ることができる。

【0053】さらに本発明によれば、受光素子の受光面 上に透光性を有する受光量調整用個別電極を形成して、 共通電極との間に介在されている表示機能をも達成する 誘電体の光の透過率を変化して、その受光面への受光量 チング素子を用いるアクティブマトリクス表示装置に関 30 を調整する。これによって前述の先行技術に関連して述 べた電子シャッタを用いるCCDのアイリス機能の入射 光量増設構造とは本質的に異なる本格的な受光量、すな わち露出の調整機能を、従来からのカメラに用いられて いる機械的絞り機構と比較して小形かつローコストで軽 量な構成で提供することができる。また本発明によれ ば、機械的な駆動部分がないので、信頼性の向上を図る ことができる。

> 【0054】本発明によれば、受光量調整用個別電極に 電圧を与えるために、受光量調整用ラインを表示のため のソースラインに沿って隣接して設けるようにしてもよ いけれども、特に本発明ではその表示のためのソースラ インなどのラインを受光量調整のためにも共用するよう にし、この目的で受光量調整用個別電極と共通電極との 間隔を、画素電極と共通電極との間隔に比べて小さく選 び、受光量調整期間において表示期間における表示用電 圧よりも低い電圧を受光量調整用個別電極に与えて画素 電極と共通電極との間の誘電体が活性化されず、しかも 受光量調整用個別電極と共通電極との間の誘電体を活性 化してその光の透過率を変化し、こうして構成をさらに

. .

なる。

【0055】さらに本発明によれば、表示を行うため に、背後にバックライトである光源を配置したいわゆる 透過形表示を行う構成において、その光源からの光を、 遮光層によって受光素子に到達することを防ぎ、これに よって受光素子が誤動作することを防ぐことができる。 これによって液晶などによる表示とイメージセンサ機能 とを組合わせた一層高性能である複合装置が実現され る。

17

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の一形態の表示および撮像のため の装置11の一部の平面図である。

【図2】表示および撮像のための装置11の図1におけ る切断面線II-IIから見た簡略化した断面図であ

【図3】一方の基板12の液晶16側から見た簡略化し た平面図である。

【図4】出力手段28の構成を簡略化して示す平面図で ある。

【図5】図4に示される受光素子27からの信号を出力 20 11 表示および撮像のための装置 する構成をさらに具体的に示す電気回路図である。

【図6】受光素子27と列シフトレジスタ29との具体 的な構成を示す平面図である。

【図7】図6の切断面線A-B-C-Dから見た断面図 である。

【図8】図7に示される受光素子27に関連する各部分 のチャネル電位を時間経過に伴って示す図である。

【図9】出力手段30の動作を説明するための簡略化し た波形図である。

【図10】受光素子27からの出力が出力端子31から 30 23 薄膜トランジスタ 読出される全体の動作を簡略化して示す図である。

【図11】本発明の実施の他の形態の一部の平面図であ

【図12】図11の切断面線XII-XIIから見た簡 略化した断面図である。

【図13】図11および図12に示される本発明の実施 の一形態の動作を説明するための簡略化した波形図であ る。

【図14】本発明の実施のさらに他の形態の図1および 図11に対応する平面図である。

【図15】図14の切断面線XV-XVから見た一部の 断面図である。

【図16】液晶に印加される実効値電圧とコントラスト との関係を示すグラフである。

【図17】図14~図16に示される本発明の実施の一 形態の動作を説明するための簡略化した波形図である。

【図18】図14~図17に示される実施の一形態に類 似する本発明の実施のさらに他の形態の動作を説明する ための簡略化した波形図である。

【図19】本発明の実施のさらに他の形態の前述の図1 50 ϕ h 1 \sim ϕ h 4 行クロックパルス

に対応する一部の平面図である。

【図20】図19の切断面線XX-XXから見た断面図 である。

【図21】図19および図20に示される本発明の実施 の一形態における光源20からの光の進む経路を示す簡 略化した断面図である。

【図22】本発明の実施の他の形態の一部の断面図であ

【図23】本発明の実施のさらに他の形態の一部の断面 10 図である。

【図24】図1~図10に示される表示および撮像のた めの装置11が搭載されたテレビジョン電話装置の簡略 化した斜視図である。

【図25】図24に示されるテレビジョン電話装置の電 気的構成を示す簡略化したブロック図である。

【図26】本発明の実施のさらに他の形態のテレビジョ ン電話装置71の簡略化した斜視図である。

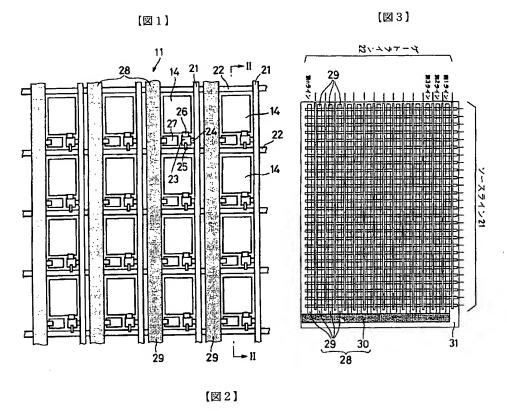
【図27】先行技術の斜視図である。

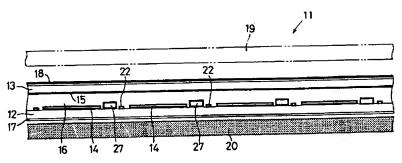
【符号の説明】

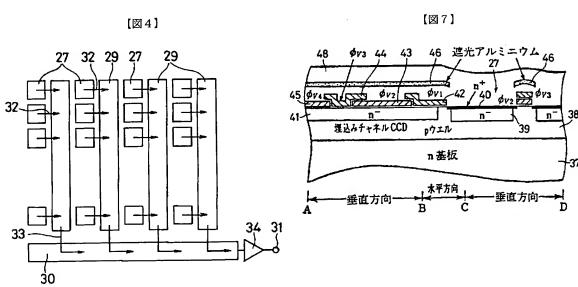
- - 12, 13 基板
 - 14 画素電極
 - 15 共通電極
 - 16 液晶
 - 17, 18 偏光板
 - 19 集光レンズ
 - 20 面状光源
 - 21 ゲートライン
 - 22 ソースライン

 - 24 ゲート電極
 - 25 ソース電極
 - 26 ドレン電極
 - 27 受光素子
 - 28 出力手段
 - 29 列シフトレジスタ
 - 30 行シフトレジスタ
 - 31 出力端子
 - 34 増幅回路
- 40 53 受光量調整用個別電極
 - 55 受光量調整用ライン
 - 58, 61, 62, 63 遮光層
 - 64,71 テレビジョン電話装置
 - 69 スピーカ
 - 70 マイクロホン
 - d1 画素電極14と共通電極15との間隔
 - d 2 受光量調整用個別電極53と共通電極15との間

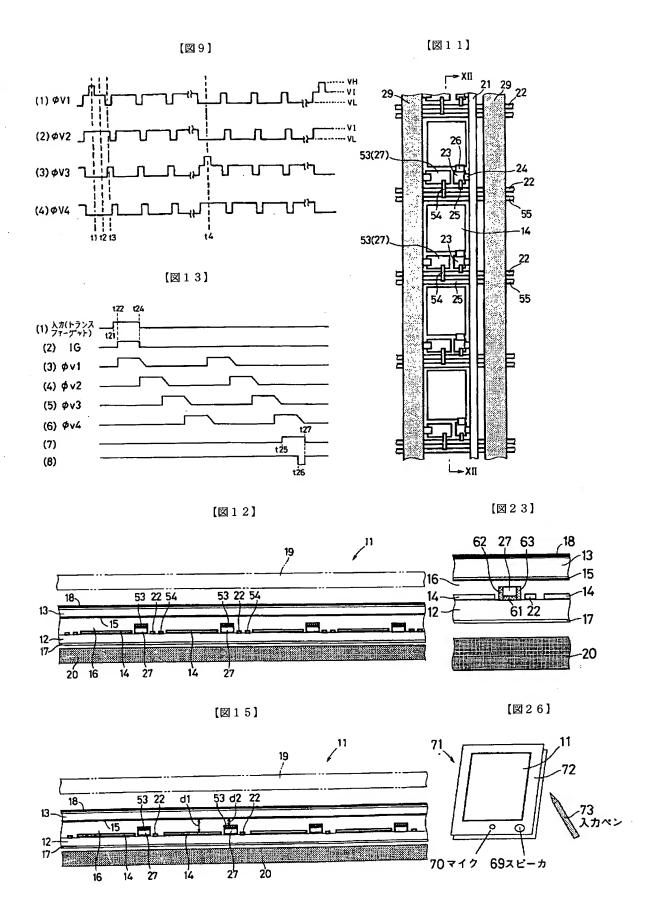
φν1~φν4 列クロックパルス

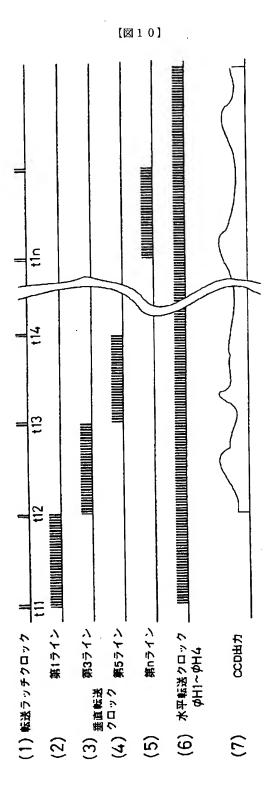


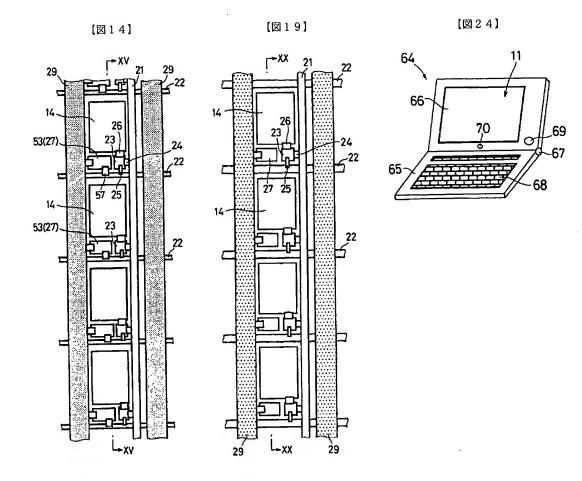




【図6】 [図5] ャネルストップ層 転送ゲート 伝送パルス 29 51下側ポリSi 垂直 CCD チャネルストッ フ拡散部 ホトダイオード (奇数番目) -27(2i+1) | ホトダイオード D (偶数番目) 水平 BCCD -27(2i) øh1 øh2 øh3 øh4 映像検出 増幅部 so上側ポリSi ----38埋込みチャネルCCD-【図16】 [図8] 表示用LCD (1) コントラスト n層 39 露出網節用LCD V1 印加实效值電圧 (2) 【図22】 (3) 27 61 -18 16 -15 (4) 22

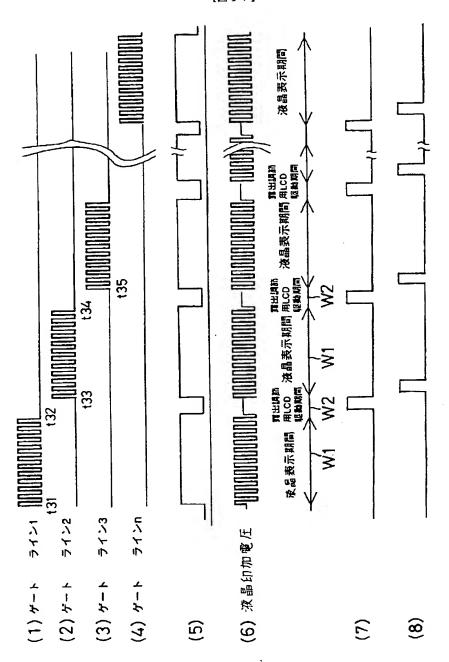




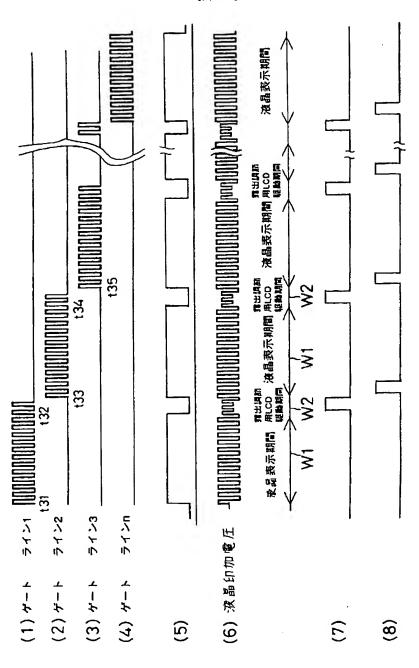


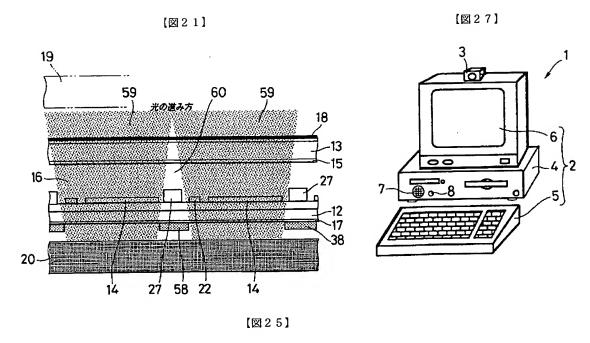
19 18 27 22 27 22 13 15 17 20 16 14 58 14

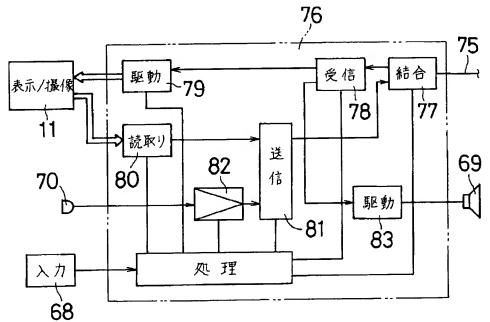












フロントページの	の続き						
(51) Int. Cl. 6 H O 4 N 5	/335	識別記号	庁内整理番号	F I H 0 4 N	7/14		技術表示箇所
5	666	102		H 0 1 L	27/14	В	

// H 0 4 N 7/14